

(4)

特開2002-222934

5

ク電流の温度依存性は皆無になる。そして、このMIM構造のキャバシタを有する半導体装置の動作が非常に安定するようになる。

【0018】そして、本発明の半導体装置では、前記第2の誘電体膜は、Ta₂O₅膜、ZrO₂膜、HfO₂膜、SrTiO₃膜、(Ba, Sr)TiO₃膜あるいはPb(Zr, Ti)O₃膜の金属酸化膜で構成されている。

【0019】また、本発明の半導体装置の製造方法は、半導体基板上にキャバシタの下部電極を金属膜で形成し原子層化学気相成長(ALCVD)法でもって前記下部電極を被覆する容量絶縁膜を形成する工程と、前記容量絶縁膜上にキャバシタの上部電極を形成する工程とを含む。この容量絶縁膜は、Ta₂O₅膜、ZrO₂膜、HfO₂膜、SrTiO₃膜、(Ba, Sr)TiO₃膜あるいはPb(Zr, Ti)O₃膜である。

【0020】あるいは、本発明の半導体装置の製造方法では、前記容量絶縁膜は第1の誘電体膜と第2の誘電体膜の積層膜で構成され、原子層化学気相成長(ALCVD)法でもって前記第1の誘電体膜を前記下部電極上あるいは前記第2の誘電体膜上に被覆させる。ここで、前記第1の誘電体膜はアルミナ膜であり、前記第2の誘電体膜は金属酸化膜で構成される。そして、前記金属酸化膜は、Ta₂O₅膜、ZrO₂膜、HfO₂膜、SrTiO₃膜、(Ba, Sr)TiO₃膜あるいはPb(Zr, Ti)O₃膜である。

【0021】上述したようなALCVD法で容量絶縁膜を成膜すると、それぞれの組成の制御が非常に向上する。また、この方法であると、成膜の段差被覆性が非常に高くなり、絶縁性に優れた高品質の容量絶縁膜が容易に形成できる。そして、この方法で形成する金属酸化膜では酸素欠損の問題が解消するようになり、その後の酸素雰囲気での高誘電率膜の熱処理工程が不要になる。このようにして、信頼性が高くしかも容量値の高いキャバシタが容易に製造できるようになる。

【0022】あるいは、本発明の半導体装置の製造方法では、前記第1の誘電体膜を被覆させる工程において、トリメチルアルミニウム(TMA)と酸化ガスとを反応ガスとした原子層化学気相成長(ALCVD)法でアルミナ膜を形成する。

【0023】そして、本発明の半導体装置の製造方法では、前記金属膜は金属酸化物あるいは金属窒化物で構成される。前記金属酸化物、金属窒化物は、RuO₂、IrO₂、TiN、Ta₂NあるいはWNである。

【0024】このようにすると、下部電極と第1の誘電体膜あるいは容量絶縁膜との密着性が非常に向上する。また、半導体装置を構成する層間絶縁膜と第1の誘電体膜あるいは容量絶縁膜との密着性も大幅に向上了し、高品質のキャバシタが形成できるようになる。

【0025】このように、本発明では、金属酸化膜のよ

6

うな高誘電率材料を容量絶縁膜に用いるMIM構造のキャバシタにおいて、下部電極あるいは上部電極と高誘電率材料との間に膜中の電子の流れがFowler Nordheim(F-N)トンネル電流機構あるいは直接トンネル電流機構となる絶縁膜を介在させる。ここで、上記容量絶縁膜を原子層化学気相成長(ALCVD)法で形成する。

【0026】このために、本発明では、MIM構造のキャバシタを搭載した半導体装置の動作が非常に安定するようになる。また、上記電極あるいは層間絶縁膜から容量絶縁膜がはがれるようなことは皆無になり、高品質の半導体装置が製造できるようになる。

【0027】

【発明の実施の形態】次に、本発明の第1の実施の形態について図1乃至図5で説明する。この第1の実施の形態でもって本発明の構成の特徴を説明する。ここで、図1乃至図3は、本発明のスタック型のキャバシタの平面図とその断面図である。図1(a)は模式化したスタック型のキャバシタの平面図であり、簡単化のため下部電極と容量絶縁膜と上部電極とが示されている。図1(b)は、図1(a)に記すA-Bでの断面図である。そして、図2と図3は上記キャバシタの一部の拡大図となっている。また、図4と図5では、本発明でのキャバシタの容量絶縁膜の形成方法を示す。

【0028】以下、図1(a)と図1(b)とを一緒にして説明する。従来の技術で説明したのと同様に、導電型がP型のシリコン基板1表面の所定の領域に導電型がN型の拡散層2が形成され、シリコン基板1上の層間絶縁膜3の一部が開口されアラグ4が形成されている。そして、下部電極5が直接に層間絶縁膜3に被覆するように形成され、下部電極5と拡散層2とはアラグ4で電気接続される。ここで、層間絶縁膜3はシリコン酸化膜で構成され、アラグ4は窒化チタン(TiN)のバリア膜とタンゲステンなどで構成され、下部電極5は二酸化ルテニウムの金属膜で構成される。

【0029】そして、層間絶縁膜3表面および下部電極5表面に第1の誘電体膜として極薄のバリア絶縁層6が被覆される。ここで、このバリア絶縁層6として、膜厚が1nm～5nmのアルミナ膜が用いられている。このアルミナ膜の比誘電率は10程度である。この場合の膜中の電流は、Fowler Nordheim(F-N)トンネル電流あるいは直接トンネル電流機構となる。

【0030】そして、第2の誘電体膜として、バリア絶縁層6に被覆する高誘電率膜7が形成される。このバリア絶縁層6と高誘電率膜7とが容量絶縁膜8を構成することになる。ここで、高誘電率膜7は膜厚10nm程度の五酸化タンタル(Ta₂O₅)である。この五酸化タンタル膜の比誘電率は25程度になる。

【0031】そして、全体を被覆するように上部電極7

(5)

特開2002-222934

8

7

が形成される。なお、この上部電極7もタングステン等の金属膜で構成される。このようにして、MIM構造のキャバシタが形成されている。

【0032】次に、図1(b)に示す点線円10部位と点線円11部位を拡大して本発明の特徴を更に説明する。図2(a)が点線円10部位を拡大した断面図であり、図2(b)が点線円11部位を拡大した断面図である。

【0033】図2(a)に示すように、下部電極5上に積層してバリア絶縁層6と高誘電率膜7とが形成され、上記高誘電率膜7表面に上部電極9が形成される。ここで、下部電極5および上部電極9は金属膜であるが、下部電極5はRuO₂膜の他にIrO₂膜、RuO₂膜/Ru膜(Ru膜上にRuO₂膜を堆積した積層膜)、IrO₂膜/Ir膜でもよい。あるいは、下部電極5としてTiN膜、TaN膜、WN膜を用いてもよい。更には、TiN膜、TaN膜でその表面をコーティングした金属膜でもよい。そして、上部電極9には、上記金属膜の他にタングステン等の高融点金属を用いてもよい。

【0034】また、バリア絶縁層6は、上述したようにF-Nトンネル電流あるいは直接トンネル電流機構を有する絶縁膜である。このバリア絶縁層6としてシリコンオキシナイトライド(SiON)膜でもよい。ここで、上述したような下部電極5とバリア絶縁層6との密着性が高くなるような材料が用いられる。そして、高誘電率膜7としては、Ta₂O₅膜の他に、二酸化ジルコニウム(ZrO₂)、二酸化ハフニウム(HfO₂)、STO(SrTiO₃)膜、BST((Ba, Sr)TiO₃)膜あるいはPZT(Pb(Zr, Ti)O₃)膜等の金属酸化膜を用いる。

【0035】また、図2(b)に示すように、層間絶縁膜3上に積層してバリア絶縁層6と高誘電率膜7とが形成され、上記高誘電率膜7表面に上部電極9が形成される。ここで、層間絶縁膜3は、二酸化シリコン膜の他にSi-O結合ベースの絶縁膜であってもよい。そのような絶縁膜としては、シルセスキオキサン類であるハイドロゲンシルセスキオキサン(Hydrogen Silsesquioxane)、メチルシルセスキオキサン(Methyl Silsesquioxane)、メチレーテッドハイドロゲンシルセスキオキサン(Methylated Hydrogen Silsesquioxane)あるいはフルオリネーテッドシルセスキオキサン(Furuorinated Silsesquioxane)のような低誘電率膜がある。

【0036】ここで、重要なことは、バリア絶縁層6として上述したような層間絶縁膜3との密着性が高くなるような材料を用いることである。上述したアルミナ膜と上記層間絶縁膜との密着性は非常に高い。

【0037】本発明における容量絶縁膜の別の構成について、図3に基づいて説明する。図3も、図1に示すようなMIM構造のキャバシタでの図2と同様に拡大した断面図である。図3(a)では、下部電極5表面に接着

して高誘電率膜7が形成される。そして、この高誘電率膜7表面にバリア絶縁層6aが形成され、このバリア絶縁層6a上に上部電極9が形成される。

【0038】また、図3(b)では、下部電極5表面に被着してバリア絶縁層6が形成され、バリア絶縁層6上に高誘電率膜7とバリア絶縁層6aが積層して形成される。そして、このバリア絶縁層6a上に上部電極9が形成される。

【0039】上記のようなMIM構造のキャバシタにおいて、下部電極5、バリア絶縁層6、6a、高誘電率膜7および上部電極9の材料は、図2(a)で説明したものと同じである。

【0040】次に、図1で説明したMIM構造のキャバシタを構成するバリア絶縁層6と高誘電率膜7の形成方法について、図4と図5に基づいて説明する。

【0041】図4(a)は、層間絶縁膜3表面および下部電極5表面にバリア絶縁層6を形成した後の断面図である。ここで、このバリア絶縁層6は、原子層化学気相成長(ALCVD: Atomic Layer Chemical Vapor Deposition)法で形成する。この場合の装置としては、マルチチャンバー成膜装置を用いる。ALCVDでの成膜においては、チャンバー(反応室)内には反応ガスをパレス状にしかも断続的に導入する。このような反応ガスの導入のガスシーケンスを図4(b)に示す。なお、成膜する半導体ウェーハは、チャンバー内で温度が200°C~350°Cの基板上に載置されている。

【0042】図4(b)に示すように、チャンバー内に窒素ガスを導入し、チャンバー内のガス圧力を100Pa程度にする。ここで、窒素ガスとしては窒素ガス、アルゴン等の不活性ガスを用いる。そして、TMA(トリメチルアルミニウム)ガスをパレス形態にチャンバー内に導入する。このTMAガスのパルス状の断続的な導入で、層間絶縁膜3表面および下部電極5表面にTMAあるいはその活性種を化学吸着させる。ここでの化学吸着は一原子層である。

【0043】ここで、TMAのアルミニ原子は酸素原子あるいは窒素原子と結合して化学吸着する。このために、下部電極5としては図2(a)のところで説明したような金属酸化物あるいは金属窒化物で導電性のある金属膜を用いる必要がある。また、層間絶縁膜3はシリコン酸化膜系の絶縁膜であるので、TMAは容易にその表面にも化学吸着するようになる。

【0044】次に、図4(b)に示すように、TMAガスを遮断しバージガスをパルス形態でチャンバー内に導入し、チャンバー内のTMAガスを排気し除去する。ここで、バージガスとしては、窒素ガス、アルゴンガス、ヘリウムガスを用いる。

【0045】そして、バージガスを遮断して、酸化ガス50をチャンバー内にパルス形態で導入する。この酸化ガス

(6)

特開2002-222934

9

は、層間絶縁膜3表面および下部電極5表面に吸着した上記TMAあるいはその活性種と熱反応し原子層レベルのアルミナ膜を成膜させることになる。なお、酸化ガスとしてはオゾン(O_3)を用いる。そして、再びバージガスをパルス形態でチャンバー内に導入する。

【0046】上述したようなTMAあるいはその活性種の吸着とその酸化とを単位サイクルとして原子層レベルのアルミナ膜を形成し、このサイクルを繰り返してバリア絶縁層6の膜厚を制御する。ここで、単位サイクルは1秒程度であり、上記原子層レベルのアルミナ膜の膜厚は0.1~0.2nmである。そこで、上述したALCVD法において、上記10サイクルあるいは20サイクル繰り返す。このようにして、膜厚が1nm~5nmのアルミナ膜を形成しバリア絶縁層6とする。

【0047】このALCVD法での基板の温度の設定は重要である。下部電極5を酸化させないことが必要になるからである。 RuO_2 膜のように導電性のある金属酸化物では問題が生じないが、 TiN 膜、 TaN 膜のような金属窒化物ではその酸化を防止する必要がある。ここで、 TiN 膜の酸化は450°C以上、 TaN 膜の酸化は500°C以上でそれぞれ起こる。そこで、ALCVD法での基板温度は400°C以下に設定するとよい。

【0048】上述したようなALCVD法により、層間絶縁膜3表面および下部電極5表面に対して非常に高い密着性を有するバリア絶縁層6が形成できるようになる。

【0049】次に、上述したバリア絶縁層6上に高誘電率膜7を形成する。図5(a)は、層間絶縁膜3表面および下部電極5表面上のバリア絶縁層6表面に被着するように高誘電率膜7を成膜した後の断面図である。

【0050】ここで、この高誘電率膜7を上述したALCVD法で形成する場合を説明する。この場合に、上述したマルチチャンバー成膜装置のうち別のチャンバー(反応室)内に反応ガスをパルス状にしかも断続的に導入する。このような反応ガスの導入のガスシーケンスを図5(b)に示している。なお、この場合も成膜する半導体ウェーハは、上記チャンバー内で温度が200°C~350°Cの基板上に載置されている。

【0051】図5(b)に示すように、チャンバー内に雰囲気ガスを導入し、チャンバー内のガス圧力を200Pa程度にする。そして、ソースガスとして四塩化タンタル($TaCl_4$)ガスをパルス形態でチャンバー内に導入する。このソースガスのパルス状の断続的な導入で、バリア絶縁層6表面に Ta 原子あるいはタンタルの塩化物を化学吸着させる。ここでの化学吸着は一原子層あるいは数原子層である。ここで、 Ta 原子は酸素に対して化学吸着するために、バリア絶縁層6表面に容易に化学吸着する。

【0052】次に、図5(b)に示すように、ソースガスを遮断しバージガスをパルス形態でチャンバー内に導

10

入し、チャンバー内のソースガスを排気し除去する。そして、バージガスを遮断して、酸化ガスをチャンバー内にパルス形態で導入する。この酸化ガスは、上記吸着した Ta 原子と熱反応し原子層レベルの五酸化タンタル膜を成膜させることになる。なお、酸化ガスとしては水(H_2O)、オゾン等を用いる。そして、再びバージガスをパルス形態でチャンバー内に導入する。上述したような Ta 原子の吸着とその酸化とを単位サイクルとして原子層レベルあるいは数原子層レベルの酸化タンタル膜を形成し、このサイクルを繰り返して高誘電率膜7の膜厚を制御する。ここで、五酸化タンタル膜の成膜速度は5nm/miin程度である。このために、膜厚が10nmの五酸化タンタル膜を形成する場合には、成膜時間は2miin程度となる。

【0053】上述したようなALCVD法でバリア絶縁層6と高誘電率膜7を成膜すると、それぞれの組成の制御が非常に向上する。また、この方法であると、成膜の段差被覆性が非常に高くなり、絶縁性に優れた高品質の容量絶縁膜が容易に形成できる。そして、この方法で形成する高誘電率膜では酸素欠損の問題が解消するようになり、その後の酸素穿孔気での高誘電率膜の熱処理工事が不要になる。上記の効果は、高誘電率膜が五酸化タンタル膜の場合に限らず、図2の説明の中で示した金属酸化膜の場合にも同様に生じる。

【0054】次に、本発明の第2の実施の形態について図6と図7を参照して説明する。この実施の形態は、0.10μmの設計基準で製造するロジックデバイスにMIM構造のキャバシタが形成される場合である。ここで、本発明の容量絶縁膜中のリーク電流において生じる効果を具体的に示す。

【0055】図6(a)に示すように、導電型がP型のシリコン基板21表面に素子分離領域22をSTI(S Hallow Trench Isolation)法で形成する。そして、シリコン基板21上にゲート絶縁膜を介して多結晶シリコン層23を形成し、この多結晶シリコン層23の側壁に公知の方法でサイドウォール絶縁膜24を形成する。

【0056】そして、導電型がN型のソース・ドレイン拡散層25をイオン注入と熱処理とで形成する。更にシリサイド技術で多結晶シリコン層23の表面とソース・ドレイン拡散層25の表面に選択的にシリサイド層26を形成する。ここで、シリサイド層26はコバルトシリサイドで形成される。

【0057】次に、シリコン窒化膜で保護絶縁膜27を形成し、シリコン酸化膜で第1層間絶縁膜28を積層して形成する。そして、第1層間絶縁膜28の所定の領域を開口しアラグ29を形成する。ここで、アラグ29はタンゲステンで構成される。

【0058】次に、エッチングストッパー層30と第2層間絶縁膜31を積層して堆積させる。ここで、エッチ

(7)

特開2002-222934

11

12

ングストッパー層30は薄いシリコン窒化膜であり、第2層間絶縁膜31はシリコン酸化膜である。

【0059】この第2層間絶縁膜31の所定の領域を反応性イオンエッチング(RIE)でドライエッチングし容量用開孔32を形成する。ここで、エッチングストッパー層30は、上記RIEにおけるドライエッチングからプラグ29を保護する。そして、続くドライエッチングでエッチングストッパー層30を選択的に除去して上記容量用開孔32は形成される。

【0060】次に、図6(b)に示すように、容量用開孔32の内面に沿って下部電極33を形成する。この下部電極33はプラグ29と接続している。ここで、下部電極33は膜厚が20nm程度のTIN膜で構成される。

【0061】次に、図7(a)に示すように、下部電極33および第2層間絶縁膜31表面に、第1の実施の形態で説明したように、バリア絶縁層34を膜厚2nmのアルミナ膜で形成し、更に、高誘電率膜35を膜厚10nmの五酸化タンタルで形成する。

【0062】次に、図7(b)に示すように、高誘電率膜35上にバリア導電層36とタンクスチタン膜37を形成し、公知のフォトリソグラフィ技術とドライエッチング技術とでパターニングし上部電極38とする。このようにして、MIM構造のキャバシタの基本構造が完成する。

【0063】このようにして形成したMIM構造のキャバシタのリーク電流について詳細に調べた。その結果を図8で説明する。ここで、図8では、横軸に下部電極33と上部電極38間に印加する電圧をとっている。具体的には、ソース・ドレイン拡散層25およびシリコン基板21を接地電位にし、上部電極38に正負の電圧を印加している。そして、縦軸に容量(絶縁)膜中のリーク電流Jをとっている。また、測定温度をバラメーターとして室温(25°C)、85°C、125°Cにしている。

【0064】図8から判るように、本発明では、容量膜中のリーク電流は全く測定温度に依存しなくなる。これは、バリア絶縁層34中を流れる電流に温度依存性が全く無くなるからである。ここで、バリア絶縁層34中の電子の流れは、FowlerNordheim(F-N)トンネル電流あるいは直接トンネル電流機構になる。

【0065】比較として、従来のMIM構造のキャバシタの場合について説明する。従来の技術の構造は図9に示している。ここで、下部電極33上に高誘電率膜35を被着させる他は、第2の実施の形態で説明したのと同じ構成である。すなわち、下部電極33上に高誘電率膜35が膜厚10nmの五酸化タンタルで形成され、高誘電率膜35上にバリア導電層36とタンクスチタン膜37とで上部電極38が形成されている。

【0066】このようにして形成したMIM構造のキャ

バシタのリーク電流の結果を図10で説明する。ここで、図10では、横軸に下部電極33と上部電極38間に印加する電圧をとり、縦軸に容量(絶縁)膜中のリーク電流Jをとっている。また、測定温度をバラメーターとして室温(25°C)、85°C、125°Cにしている。図10から判るように、従来の構造では、容量膜中のリーク電流は測定温度に大きく依存する。すなわち、測定温度が上がるとリーク電流が増大するようになる。これは、図12に説明した特性の具体例となっている。

【0067】第2の実施の形態では、バリア絶縁層34が下部電極33表面に形成される場合について説明しているが、第1の実施の形態で図3に基づいて説明したのと同様に、バリア絶縁層が高誘電率膜と上部電極間に介在する場合、あるいは、バリア絶縁層が下部電極と高誘電率膜間および上部電極と高誘電率膜間に介在する場合でも、容量絶縁膜中のリーク電流の温度依存性は消滅する。

【0068】以上の実施の形態においては、下部電極あるいは上部電極に用いる金属膜として、オスミウム(Os)もしくはその酸化物あるいはレニウム(Re)、白金(Pt)、パラジウム(Pd)、ロジウム(Rh)を用いてもよい。しかし、上述したALCVD法でバリア絶縁層を形成する場合には、上記レニウム、白金、パラジウム、ロジウム等の金属膜の表面に酸素あるいは水酸基を吸着させておく必要がある。また金属膜としては、チタン(Ti)、タンタル(Ta)、ルテニウム(Ru)、イリジウム(Ir)を用いてもよい。更には、導電性のある金属化合物を用いてもよい。このような金属化合物としては、上述した金属酸化物、金属窒化物の他に、金属の酸窒化物、炭化物等がある。

【0069】あるいは、下部電極あるいは上部電極を構成する金属膜として、異種の金属膜を積層して用いてもよい。

【0070】また、上記の実施の形態では、バリア絶縁層としてアルミナ膜、SiON膜について説明したが、バリア絶縁層はF-Nトンネル電流あるいは直接トンネル電流機構を有する絶縁膜であればよい。

【0071】また、上記の実施の形態では、ALCVD法で五酸化タンタル膜を形成する場合について詳述した。このALCVD法で高誘電率膜である二酸化ジリコニウム(ZrO₂)、二酸化ハフニウム(HfO₂)、STO(SrTiO₃)膜、BST((Ba, Sr)TiO₃)膜を成膜する場合には、図5(b)に示したソースガスとして、それぞれ、塩化ジルコニウムあるいはZrのアルコラート、塩化ハフニウム、ストロンチウムDRM、バリウムDRM、塩化チタンを用いるとよい。

【0072】上記の高誘電率膜の比誘電率は、二酸化ジリコニウム(ZrO₂)でその比誘電率は25、二酸化ハフニウム(HfO₂)で30、STO(SrTiO₃)膜で100、BST((Ba, Sr)TiO₃)膜

(8)

特開2002-222934

13

で300程度と安定して容量値の高い容量絶縁膜となる。なお、この場合の成膜温度は上述したような200°C~350°Cでよい。

【0073】また、上述したALCVD法で上記のような金属酸化膜を成膜すると、この金属酸化膜をMIM構造のキャバシタの容量絶縁膜として使用できるようになる。なお、このような金属酸化膜は異種のものを積層して用いてもよい。

【0074】

【発明の効果】以上に説明したように、本発明の主要部では、金属酸化膜のような高誘電率材料を容量絶縁膜に用いるMIM構造のキャバシタにおいて、キャバシタの下部電極あるいは上部電極と上記高誘電率材料との間に、膜中の電子の流れがFowler Nordheim (F-N) トンネル電流機構あるいは直接トンネル電流機構となる絶縁膜をバリア絶縁層として介在させる。あるいは、上記バリア絶縁層あるいは容量絶縁膜を原子層化学気相成長 (ALCVD) 法で形成する。

【0075】このために、本発明では、容量絶縁膜の組成の制御が非常に向上すると共に、成膜の段差被覆性が非常に高くなる。そして、高い誘電率で絶縁性に優れ、動作温度依存性の小さな高品質の容量絶縁膜が容易に形成できる。

【0076】このようにして、MIM構造のキャバシタを搭載した半導体装置の動作が非常に安定するようになる。そして、高誘電率膜をキャバシタの容量絶縁膜とした、信頼性の高いスタック型のキャバシタが可能になり、半導体装置の超高集積化および高密度化が大幅に促進される。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の第1の実施の形態を説明するためのMIM構造キャバシタの平面図とその断面図である。

【図2】上記MIM構造キャバシタの一部拡大した断面図である。

【図3】別のMIM構造キャバシタの一部拡大した断面図である。

【図4】本発明の容量絶縁膜の成膜方法を説明するためのキャバシタ断面図と反応ガスの導入シーケンス図である。

14

【図5】本発明の容量絶縁膜の成膜方法を説明するためのキャバシタ断面図と反応ガスの導入シーケンス図である。

【図6】本発明の第2の実施の形態を説明するためのMIM構造キャバシタの製造工程順の断面図である。

【図7】上記MIM構造キャバシタの製造工程の続きを示す工程順の断面図である。

【図8】本発明の効果を説明するためのグラフである。

【図9】本発明の第2の実施の形態と対比するための従来のMIM構造キャバシタの断面図である。

【図10】上記従来のMIM構造キャバシタの容量絶縁膜中のリーク電流を示すグラフである。

【図11】従来の技術で形成したMIM構造キャバシタの平面図と断面図である。

【図12】従来の技術での課題を説明するための容量膜中のリーク電流の測定温度依存性を示すグラフである。

【符号の説明】

1, 21, 101 シリコン基板

2, 102 拡散層

20 3, 103 層間絶縁膜

4, 29, 104 プラグ

5, 33, 105 下部電極

6, 6a, 34 バリア絶縁層

7, 35 高誘電率膜

8, 106 容量絶縁膜

9, 38, 107 上部電極

10, 11 点線円

22 素子分離領域

23 多結晶シリコン層

30 24 サイドウォール絶縁膜

25 ソース・ドレイン拡散層

26 シリサイド層

27 保護絶縁膜

28 第1層間絶縁膜

30 29 エッチングストッパー層

31 第2層間絶縁膜

32 容量開孔

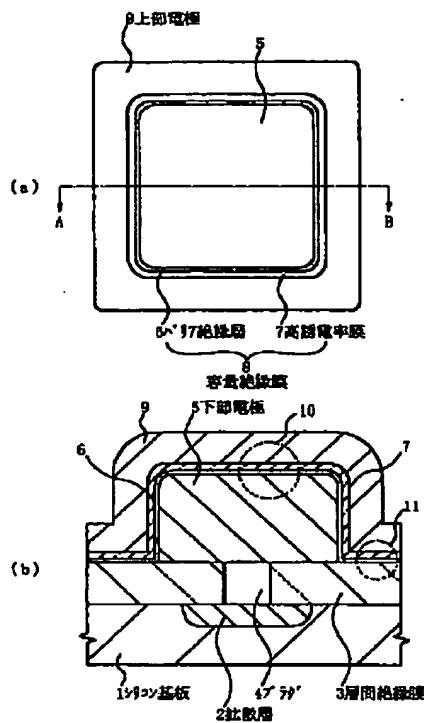
36 バリア導電層

37 タングステン膜

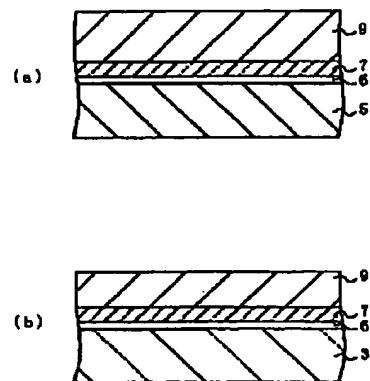
(9)

特開2002-222934

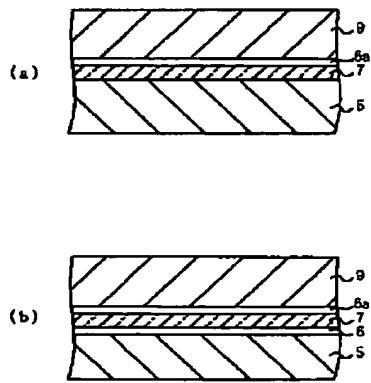
【図1】



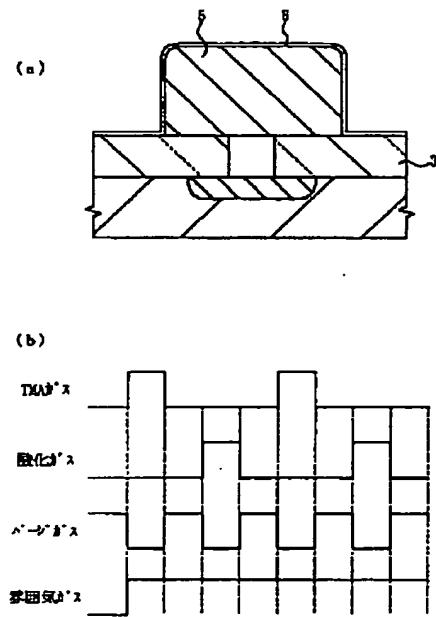
【図2】



【図3】



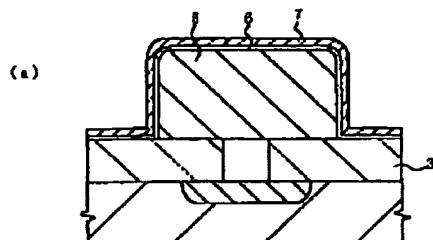
【図4】



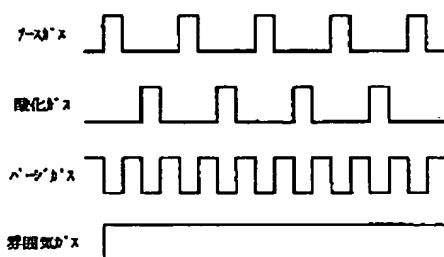
(10)

特開2002-222934

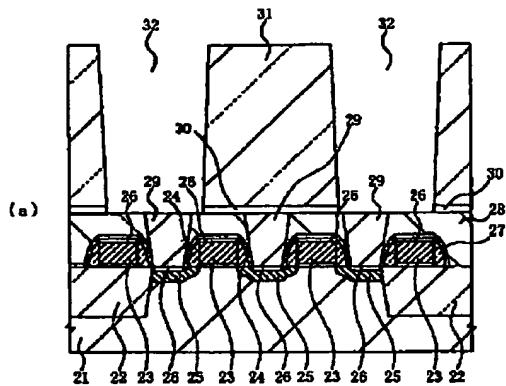
【図5】



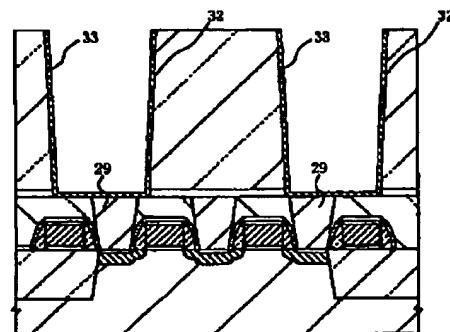
(b)



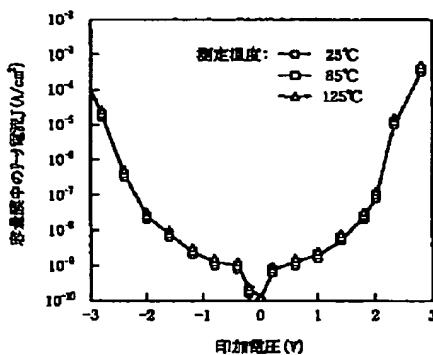
【図6】



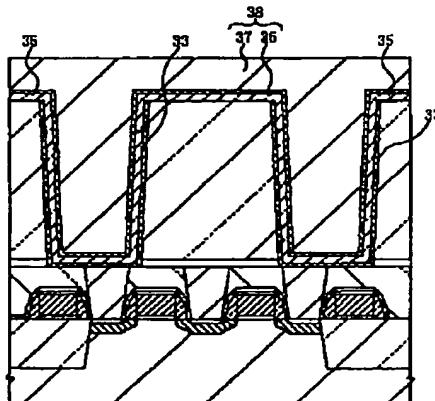
(b)



【図8】



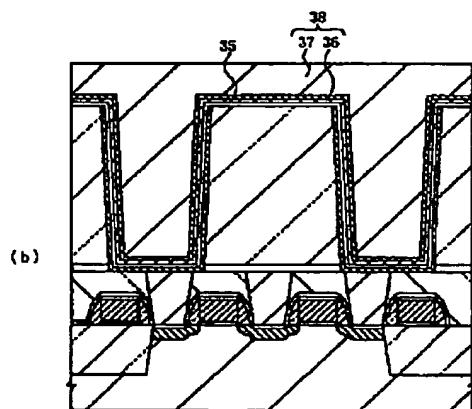
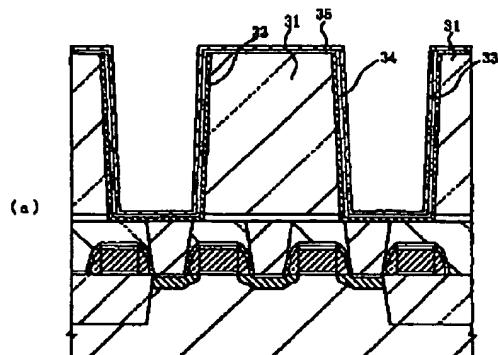
【図9】



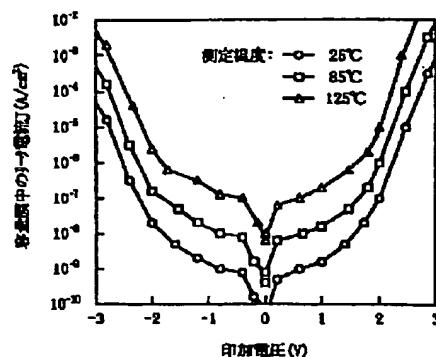
(11)

特開2002-222934

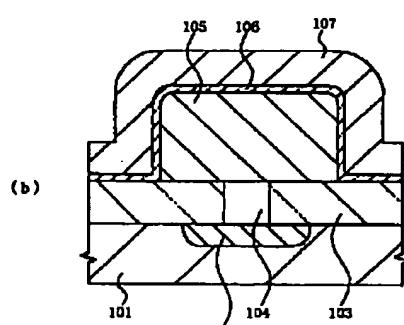
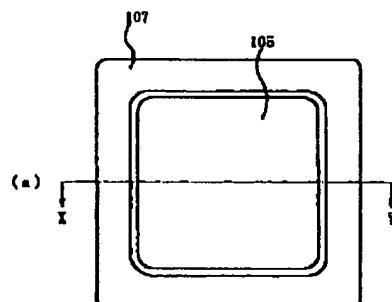
【図7】



【図10】

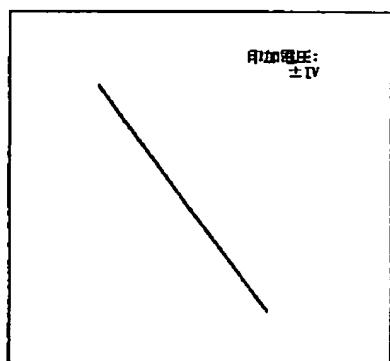


【図11】



【図12】

検査結果中のJ-V電流、J-V(伏安表示)

測定温度の逆数 $1/T (K^{-1})$

(12)

特開2002-222934

フロントページの継ぎ

Fターム(参考) SF083 AD24 AD42 GA06 JA03 JA05
JA06 JA14 JA15 JA17 JA35
JA38 JA39 JA40 JA43 MA06
MA17 NA01 PR21